



DKZ/5/2012

Warszawa, dnia 20.01.2012r.

Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami) dalej "ustawa Pzp".

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
dostawę plazmowego implantatora jonów PIII**

słownik CPV 31700000

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Instytut Technologii Elektronowej
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46

adres internetowy: <http://www.ite.waw.pl>

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ww. ustawy.

Oferty złożone w postępowaniu zostaną otwarte i ocenione przez Komisję Przetargową zgodnie z kryterium oceny ofert.

Spośród wszystkich, nie podlegających odrzuceniu ofert zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg kryterium oceny ofert.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego **plazmowego implantatora jonów PIII**, zwanego dalej „urządzeniem”.

Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia przedstawione są w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Składanie ofert częściowych i wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia - maksymalnie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

W postępowaniu Zamawiający żąda od wykonawców wykazania się spełnieniem warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej 1 dostawę plazmowego implantatora jonów PIII.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem, iż taki podmiot będzie brał udział w realizacji przedmiotowego zamówienia. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków opisanych przez zamawiającego polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26. ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w punkcie 7.1.2. lub 7.2.2. SIWZ.

Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

7.1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce:

7.1.1. Wykaz dostaw (na potwierdzenie spełniania warunku „**wiedza i doświadczenie**”) – wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę plazmowego implantatora jonów PIII, z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że ta dostawa została wykonana należycie.

Zamawiający zaleca wypełnienie załącznika nr 4 do SIWZ.

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

7.1.3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4 – 8 ustawy Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

7.1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.6. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.1.7. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - w formie dokumentu: „OŚWIADCZENIE” stanowiące Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do SIWZ.

7.2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

7.2.1. Wykaz dostaw (na potwierdzenie spełniania warunku „**wiedza i doświadczenie**”) – wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę plazmowego implantatora jonów PIII, z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że ta dostawa została wykonana należycie.

Zamawiający zaleca wypełnienie załącznika nr 4 do SIWZ.

7.2.2. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2.3. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2.4. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.2.5. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4 – 8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2.6. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - w formie dokumentu: „OŚWIADCZENIE” stanowiące Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do SIWZ.

7.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 7.2.2. do 7.2.5. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, dokumenty określone w punkcie 7.1.2. lub 7.2.2. wykonawca składa również w odniesieniu do tych podmiotów.

7.5. O zamówienie mogą ubiegać się podmioty występujące wspólnie. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie każdy z partnerów samodzielnie złoży dokumenty, o których mowa w punktach 7.1.2. do 7.1.6. SIWZ, oraz w przypadku wykonawców występujących wspólnie, a mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą odpowiednio w punktach 7.2.2. do 7.2.5. SIWZ.

7.6. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z partnerów składa samodzielnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp podmioty te mogą złożyć łącznie.

7.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

Brak złożenia wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania z zastrzeżeniem możliwości wezwania wykonawcy do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest mgr Michał Urbański e-mail urbanski@ite.waw.pl

Pisemną korespondencję do zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Instytut Technologii Elektronowej
Al. Lotników 32/46,
02-668 Warszawa.
Zespół Zamówień Publicznych
Budynek VI, pokój nr 216.

Fax: + 48 22 548 78 46

9. Wymagania dotyczące wadium:

Wadium w kwocie 100 000,00,- PLN (słownie: sto tysięcy złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek zamawiającego przed otwarciem ofert. Wadium należy wpłacić przelewem na konto bankowe: BRE Bank S.A. O/Warszawa 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001 (IBAN PL 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001 SWIFT BREXPLPW).

Wadium składane w innej formie należy złożyć w oryginale w Kasie Instytutu Technologii Elektronowej 02 – 668, Al. Lotników 32/46, budynek VI pok. 218 (w dni robocze w godz. 9:00 – 14:00). Wadium należy złożyć przed otwarciem ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i ust. 5 ustawy Pzp.

10. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi : 60 dni od daty składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę należy złożyć na piśmie zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, tj. musi zawierać w szczególności:

- a) dokładną nazwę i adres wykonawcy,

- b) datę sporządzenia oferty,
- c) cenę - dopuszcza się podanie ceny w jednej z walut: PLN, EUR, USD, GBP. W przypadku złożenia ofert w EUR, USD lub GBP dla porównania cen ofert zastosowany zostanie przelicznik na złote polskie – PLN. Przelicznik ten będzie zgodny z kursem sprzedaży walut NBP jaki będzie obowiązywał w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.

Do oferty należy załączyć:

- wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,
- dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymienione odpowiednio w punktach 7.1. lub 7.2. SIWZ.

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

W przypadku udziału w postępowaniu firm spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się złożenie oferty, a także dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji w języku polskim lub w języku angielskim.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia **01.03.2012r.** do godziny **10:00** (w dni robocze w godz. 9:00÷14:00) w siedzibie zamawiającego w Warszawie, Al. Lotników 32/46, bud VI pokój nr 216.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.03.2012r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Warszawie, Al. Lotników 32/46 w budynku VI pokój nr 120.

Ofertę należy złożyć w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez naruszenia opakowania (np. w zaklejonej kopercie). Na kopercie lub opakowaniu powinna być umieszczona nazwa i adres firmy składającej ofertę, a także powinien znajdować się napis: Instytut Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46, 02 – 668 Warszawa. Budynek VI, pokój 216. Oferta w przetargu nieograniczonym na „dostawę plazmowego implantatora jonów PIII” – nie otwierać do dnia 01.03.2012r. do godz. 10:15.

13. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, które wykonawca musi ponieść w celu zgodnej z prawem realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, m.in.:

- a) cenę urządzenia opisanego w punkcie 3 SIWZ,
- b) instalację,
- c) uruchomienie,
- d) testowanie urządzenia,
- e) transport,
- f) warunki dostawy: DDP Piaseczno,
- g) ubezpieczenie,
- h) szkolenie osób zgodnie z punktem 18 załącznika nr 1 do SIWZ.

Cena oferty musi uwzględniać także wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia.

Wykonawca musi podać cenę oferty zgodnie z formularzem ofertowym, tj. w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.

Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w formularzu ofertowym mogą podać wyłącznie wartość netto bez podatku VAT.

16.2 Gwarancja:

- 1) Dostawca wystawi dokument gwarancyjny.
- 2) Dostawca gwarantuje prawidłowe działanie i jakość techniczną dostarczonego przedmiotu umowy w ciągu (okres gwarancji w ofercie) miesięcy od daty dostawy.
- 3) Dostawca w ramach gwarancji pokrywa koszty naprawy lub wymiany wadliwego towaru, jak również pokrywa koszty związane z jego transportem.
- 4) W okresie gwarancji Dostawca ma obowiązek zrealizować naprawę lub wymianę nie później niż w okresie 12 tygodni od daty pisemnego zgłoszenia usterek.
- 5) Gwarancja zostanie przedłużona o czas ewentualnej naprawy przedmiotu umowy.
- 6) Wymienione lub naprawione części zostaną objęte gwarancją Dostawcy lub Producenta.
- 7) W okresie gwarancji, Dostawca gwarantuje czas reakcji serwisu maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia usterek.

16.3 Instrukcja dostawy:

- 1) Przedmiot umowy będzie wysłany na poniższy adres i pozostawiony do dyspozycji Kupującego.

Adres dostawy: Instytut Technologii Elektronowej,
 ul. Puławska 34
 05-500 Piaseczno

- 2) Dostawca zawiadomi Kupującego faksem o wysyłce (Nr +48 22 54-87-803).
- 3) Dostawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy deklarację zgodności CE urządzenia.

16.4 Warunki płatności:

Płatność zostanie dokonana w następujący sposób:

- 1) 80% wartości umowy – (wartość z oferty) – płatne przekazem bankowym na podstawie oryginału faktury i dokumentów przewozowych na konto Dostawcy w ciągu 7 dni od daty wysłania przedmiotu umowy.
- 2) 20% wartości umowy – (wartość z oferty) – płatne przekazem bankowym na podstawie oryginału faktury na konto Dostawcy w ciągu 14 dni od daty wykonania testu akceptacyjnego w siedzibie Kupującego i podpisania przez obie strony Umowy protokołu odbioru.

Kupujący zapłaci Dostawcy przekazem bankowym kwotę za przedmiot umowy na konto Dostawcy w:

.....
.....

Koszty bankowe na terenie Polski ponosi Kupujący, a poza jej granicami – Dostawca.

16.5 Odbiór przedmiotu umowy:

1. Wstępny test akceptacyjny przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony w siedzibie Dostawcy przez przedstawicieli Kupującego i Dostawcy. Wstępny test akceptacyjny obejmie wykonanie testów funkcjonalnych urządzenia potwierdzających jego parametry techniczne zgodnie z punktem 17 Załącznika Nr 1 do SIWZ.

Potwierdzenie wstępnego odbioru przedmiotu umowy nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Kupującego i Dostawcy protokołu odbioru wstępnego.

2. Końcowy test akceptacyjny przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Kupującego. Końcowy test akceptacyjny obejmie wykonanie testów funkcjonalnych urządzenia potwierdzających jego parametry techniczne zgodnie z punktem 17 Załącznika Nr 1 do SIWZ.

Potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy nastąpi poprzez podpisanie przez przedstawicieli Kupującego i Dostawcy protokołu odbioru ostatecznego.

16.6 Siła wyższa:

- 1) W przypadku działania siły wyższej strony Umowy są zwolnione od odpowiedzialności za nie wywiązanie się ze swoich zobowiązań lub zobowiązania te będą zmienione, zgodnie z zapisem punktu 4. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszystkie wydarzenia, nie dające się przewidzieć przez żadną ze stron w dniu podpisania Umowy i występujących po tej dacie, nie dających się uniknąć i pozostających poza kontrolą obydwu stron.
- 2) Przypadkami siły wyższej są np. powódź, trzęsienie ziemi, pożar, wybuch, wojna, mobilizacja, strajki, blokady, generalny brak środków transportu.
- 3) Strona Umowy chcąc zgłosić roszczenia wynikające z siły wyższej ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę o jej wystąpieniu i zakończeniu.
- 4) Strona zgłaszająca roszczenia musi udowodnić drugiej stronie wystąpienie siły wyższej przy pomocy dokumentów wydanych przez odpowiednie, uprawnione do tego władze w swoim kraju. Daty i terminy wypełnienia zobowiązań zostaną przełożone lub przedłużone o okres, w którym zaistniała siła wyższa.

16.7 Zmiana umowy:

- 1) Kupujący zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn organizacyjnych lub technicznych leżących jedynie po stronie Kupującego, w szczególności: wykonywania planowych prac technologicznych w ramach realizowanych projektów, awarii oraz ewentualnych opóźnień wynikających z prowadzenia prac modernizacyjnych w laboratorium zamawiającego.
- 2) Kupujący dopuszcza możliwość zmiany całkowitej wartości przedmiotu zamówienia z tytułu ewentualnej zmiany stawki podatku VAT.

16.8 Rozstrzygnięcie sporów:

Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, których nie da się wyjaśnić polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z regulaminem tego Sądu.

17. Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Tryb udzielania wyjaśnień na temat SIWZ:

W terminie do dnia 13.02.2012r. wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający odpowie na wszystkie zapytania, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający zamieści treść pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy Pzp (dostęp do powyższych informacji - strona internetowa www.uzp.gov.pl).

20. Inne:

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Technicznych

mgr Michał Urbański

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej z projektu nr POIG 02.01.00-14-081/09 pt. Mikrosystemy i NanoTechnologie Elektroniczne dla Innowacyjnej Gospodarki „MINTE”.

Wymagania i parametry techniczne Plazmowego Implantatora Jonów PIII

Lp.	Nazwa parametru	Wymaganie	Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę*
1	2	3	4
1.	Typ		podać
2.	Producent		podać
3.	Kraj pochodzenia		podać
4.	Rok produkcji	2012	potwierdzić
5.	Plazmowy Implantator Jonów	Urządzenie fabrycznie nowe	potwierdzić
6.	Zastosowanie	<p>System ma służyć do plazmowej implantacji jonowej w następujących aplikacjach:</p> <p>a/ mikroelektronice (MEMS, Przyrządy mocy, MOS, FinFET, Pamięci, Układy logiczne)</p> <ul style="list-style-type: none"> - domieszkowanie Źródła/Drenu, - domieszkowanie głębokich rowków typu „trench” - domieszkowania płytek od spodu - wysokodozowe domieszkowanie polikrzemu - domieszkowanie kontaktów - wytwarzania bardzo płytkich złącz - domieszkowanie 3-wymiarowych elementów <p>b/nanoelektronice, modyfikacji materiałów i powierzchni</p> <ul style="list-style-type: none"> - modyfikacja prac wyjścia - wytwarzanie nanowytrąceń i nanostruktur w zawansowanych pamięciach i optoelektronice - geterowanie za pomocą implantacji wodoru - modyfikacja nanorurek węglowych - utwardzanie polimerów <p>c/ nisko-kosztowe domieszkowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> - złącz ogniw słonecznych wraz z geterowaniem wodorowym - płaskopanelowych wyświetlaczy TFT 	potwierdzić
7.	Wymagania ogólne	<p>1/ Moc elektryczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Napięcie zasilania: 3 fazy, 400V AC, 50Hz, +N, +Gnd <p>2/ Rodzaje jonów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bor (B^+) z BF_3, implantowany jon - Fosfor (P^+) z PH_3, implantowany jon - Arsen (As^+) z AsH_3, implantowany jon - Krzem (Si^+) z SiF_4, implantowany jon - Węgiel (C^+) z CF_4 (wymienne Argon-Ar^+ czy Azot-N^+) implantowany/czyszczący jon - Trójfluorek azotu NF_3 - czyszczący jon <p>3/ Rozmiary implantowanych płytek Si:</p> <ul style="list-style-type: none"> - $\varnothing 100mm$ (4”), $\varnothing 150 mm$ (6”) - uchwyt $\varnothing 300 mm$ dla implantowanych płytek <p>4/ Zakres implantowanej dawki: $1 \times 10^{14} - 1 \times 10^{18}$ at/cm²</p> <p>5/ Zakres napięcia przyspieszenia: 100V-20kV</p>	potwierdzić

		<p>6/ Zakres prądu implantacji : 500µA-300mA przy ujemnym napięciu pulsacyjnym 100V-20kV z parametrami pulsu: - czas narostu ≤1µs, - częstotliwość ≤ 10 kHz</p> <p>7/Niejednorodność implantacji: $1\sigma \leq 3\%$</p> <p>8/ Niejednorodność implantacji między płytkami: $1\sigma \leq 3\%$</p> <p>9/ Próżnia spoczynkowa w komorze: 5×10^{-6} mbar</p> <p>10/Maksymalny dopuszczalny poziom zanieczyszczeń metalicznych: $< 5 \times 10^{11}$ at/cm² dla Al $< 1 \times 10^{11}$ at/cm² dla Na, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Hf</p> <p>11/ Poziom radiacji: < 1.0 µSv/h mierzony w odległości 10 cm od jakiegokolwiek miejsca zewnętrznej obudowy urządzenia - gwarancja od producenta</p> <p>12/ znak CE</p> <p>13/ Ogólne wymiary implantatowa: (składającego się z komory procesowej wraz z systemem pompującym, modułu zasilania gazami i modułu elektrycznego) a/ szerokość: ≤ 1,25 m (mierzona u podstawy) b/ długość: ≤3,25 m (mierzona u podstawy) c/ wysokość: ≤ 2,30 m</p>	
8.	Konfiguracja komory procesowej	<p>1/ Komora procesowa musi być wykonana ze stopu aluminiowego</p> <p>2/Musi być wyposażona w 1 zestaw osłon metalowych umożliwiających szybkie jej czyszczenie</p> <p>3/ Komora od strony przedniej musi posiadać drzwi umożliwiające ręczny załadunek metalowego Ø300 mm uchwytu (z płytkami) na stolik procesowy</p> <p>4/ Musi posiadać od strony tylnej jeden port do przyłączenia systemu ręcznego załadunku płytek, składającego się z próżniowej komory śluzowej, zaworów próżniowych i uchwytu transportującego /załadowczego płytek na stolik procesowy</p> <p>5/ Musi posiadać kołnierz na górze komory umożliwiający jej podłączenie do systemu odciągowego gazów</p>	potwierdzić
9.	Przenoszenie i załadunek płytek	<p>1/ Musi mieć możliwość ręcznego załadunku uchwytu Ø300mm z płytkami na stolik procesowy bezpośrednio poprzez frontowe drzwi komory procesowej z użyciem cyklu zapowietrzania/pompowania</p> <p>2/Musi mieć możliwość ręcznego załadunku uchwytu Ø300mm z płytkami na uchwyt transportowy poprzez komorę śluzową (oddzieloną od komory procesowej zaworami próżniowymi, przy użyciu cyklu zapowietrzania/pompowania) i następnie załadunku uchwytu z płytkami na stolik procesowy za pomocą ramienia transportowego przesuwanego magnetycznie i sterowanego programowo</p> <p>3/ System musi być wyposażony w: - 2 uchwyty aluminiowe o średnicy Ø300 mm z zagłębieniami na płytce Si - 1 uchwyt o średnicy Ø300 mm wykonany z krzemu z zagłębieniami na płytce krzemowe</p>	potwierdzić

10.	Konfiguracja stolika roboczego (procesowego)	<p>1/ stolik roboczy musi pracować z uchwytami $\varnothing 300$ mm (wykonanymi z Al lub Si) z płytkami Si o różnych rozmiarach</p> <p>2/ Musi się obracać z kontrolowaną prędkością</p> <p>3/ Musi być chłodzony w zakresie temperatur (5-16-22)$^{\circ}$C za pomocą cieczy składającej się z mieszanki wody dejonizowanej i glikolu</p> <p>4/ Musi być wyposażony w zestaw chłodzący składający się z chłodziarki typu Chiller do chłodzenia uchwytu procesowego w zakresie temperatur (5-16-22)$^{\circ}$C i podtrzymywać oporność płynu chłodzącego w zakresie (10-15) MΩcm</p> <p>5/ Krytyczne temperatury chłodzenia procesu: <5$^{\circ}$C, >16$^{\circ}$C, >22$^{\circ}$C oraz krytyczna wartość rezystywności płynu chłodzącego: <10 MΩcm, muszą być zabezpieczone programowo w postaci alarmów</p>	potwierdzić
11.	Zasilanie gazami	<p>1/ Szafa gazowa (boks gazowy) musi zawierać 6 linii gazowych i zasilać niezależnie następujące gazy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 gazy procesowe: BF₃, PH₃, AsH₃, w */ wewnętrznych liniach niskociśnieniowych zasilanych zgodnie z systemem Uptime i SDS - 1 gaz procesowy : SiF₄ w */ wewnętrznej linii wysokociśnieniowej - 1 neutralny gaz procesowy: CF₄ (zamiennie z Argonem Ar lub Azotem N₂) w ** zewnętrżnej linii wysokociśnieniowej - 1 gaz do czyszczenia komory/linii: NF₃ w */ wewnętrznej linii wysokociśnieniowej <p>Uwaga: */ „wewnętrznej” - oznacza umieszczenie całej linii gazowej i butli wewnątrz boksu gazowego **/ „zewnętrżnej” - oznacza umieszczenie części linii gazowej i butli na zewnątrz boksu gazowego</p> <p>2/ Szafa gazowa musi być wyposażona w kominek umożliwiający podłączenie do centralnej instalacji odciągowej gazów</p> <p>3/ Linie gazowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 316L, wyposażone w zawory Swagelok VCR i APTech lub ich odpowiedniki oraz analogowe przepływomierze masy (MFC)</p> <p>4/ System gazowy musi być w pełni zautomatyzowany i sterowany za pomocą oprogramowania umożliwiającego monitorowanie konsumpcji gazów włącznie z określeniem momentu końca opróżnienia butli</p> <p>5/ Przepływy gazów procesowych muszą być sterowane poprzez przepływomierze masy w zakresie 0-10 sccm</p> <p>6/ Przepływ gazu czyszczącego (NF₃) musi być sterowany poprzez przepływomierz masy w zakresie 0-100 sccm.</p>	potwierdzić
12.	Źródło plazmy	<p>1/ Źródło ICP musi generować plazmę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o gęstości $1 \times 10^7 - 1 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ - przy ciśnieniu $1 \times 10^{-4} - 1 \times 10^{-2} \text{ mbar}$ - przy przepływie gazu procesowego 2-10 sccm <p>2/ Wymagana jest regulacja następujących funkcji/parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasilanie RF - ciśnienie i przepływ gazu - pole magnetyczne 	potwierdzić i podać

		<ul style="list-style-type: none"> - gęstość plazmy - dysocjacja cząstek - jednorodność plazmy - wybór rodzaju plazmy pulsacyjna lub ciągła <p>3/ Plazma musi być kontrolowana przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plazmowy spektrometr masy <p>4/ System musi być wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - generator 1200W, 13.56 MHz RF (Advanced Energy-AE lub odpowiednik) - układ dopasowania 5000W (AE lub odpowiednik) - zasilacz (Magnet Power Supply) 100V-12A DC (Xantrex lub odpowiednik) 	
13.	System Polaryzacji (SP)	<p>1/ Możliwość polaryzacji implantowanego podłoża ujemnym napięciem stałym lub pulsacyjnym (głównie stosowanym)</p> <p>2/ SP (w modzie pulsacyjnym) musi pracować w zakresie napięć 100V- 20kV przy prądach implantacji w zakresie 500µA-300mA (zależnie od rodzaju jonu i przepisu implantacji), przy czasie narostu pulsu napięciowego $\leq 1 \mu s$ (typ.100ns-500ns) i częstotliwości przełączania $\leq 10kHz$</p> <p>3/ System polaryzacji musi być wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokonapięciowy kondensator - system dozymetryczny wykorzystujący całkowanie prądu - wysokonapięciowy zasilacz 20 kV/300 mA - modulator (na elementach MOS) 20 kV, 100A w pik, 10kHz - system zabezpieczenia przed wyładowaniem łukowym 	potwierdzić i podać
14.	System próżniowy	<p>System musi być wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawór typu "Pendulum" DN200 VAT lub jego odpowiednikiem - pompę turbomolekularną 1600l/s- firmy Pfeifer lub jej odpowiednikiem - pełnozakresowy czujnik próżni dla kontroli próżni roboczej - czujnik typu Baratron do pomiaru ciśnienia podczas procesu - suchą pompę o wydajności 100m³/h - Adixen A103P lub równoważną 	potwierdzić
15.	Sterowanie urządzeniem	<p>1/ System sterowania urządzeniem musi się składać z: jednostki sterującej PLC, komputera typu PC, monitora dotykowego, oprogramowania zarządzającego, multiportu typu "HUB" i elementów do połączeń sieci typu Ethernet, części interfejsu użytkownika i innych elementów</p> <p>2/ Musi posiadać 4-ro kanałową możliwość monitorowania procesu poprzez następujące sygnały (wejście RF ON/OFF, wejście HV ON/OFF, prąd implantacji, wyjście polaryzacji HV)</p> <p>3/ Oprogramowanie sterujące musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - współpracę z PLC - wielopoziomowe logowanie zabezpieczone hasłem użytkownika - wybór trybu automatycznego i ręcznego z zabezpieczeniami - programowanie przepisu procesu - kontrola parametrów procesu i jego monitorowanie - raportowanie danych - wyświetlanie historii pracy i alarmów 	potwierdzić

		- możliwość wymiany informacji serwisowych za pomocą modemu telefonicznego	
16.	Inne wymagania	<p>1/ Dwa dodatkowe zestawy osłon metalowych do komory procesowej</p> <p>2/ Dwa dodatkowe uchwyty aluminiowe o średnicy $\varnothing 300$ mm na płytce krzemowe</p> <p>3/ Jeden dodatkowy uchwyt wykonany z krzemu o średnicy $\varnothing 300$ mm na płytce krzemowe</p>	potwierdzić i podać
17.	Test akceptacyjny	<p>Dwuetapowy:</p> <p>1/Wstępny test akceptacyjny w siedzibie producenta urządzenia obejmujący:</p> <p>Test 1 : Napięcie przyspieszające : 100 V DC Prąd implantacji: ~1 mA Doza : 1×10^{14} at /cm² Użyty gaz: Azot Liczba płytek Si $\varnothing 100$mm (4"): 3</p> <p>Test 2 : Napięcie przyspieszające : 100 V Puls Prąd implantacji: ~100 mA Doza : 1×10^{16} at /cm² Użyty gaz: Azot Liczba płytek Si $\varnothing 100$mm (4"): 3</p> <p>Test 3 : Napięcie przyspieszające : 10 kV Puls (lub 20kV Puls) Prąd implantacji : ~1 mA Doza : 1×10^{14} at /cm² Użyty gaz: Azot Liczba płytek Si $\varnothing 100$mm (4"): 3</p> <p>Test 4 : Napięcie przyspieszające : 10 kV Puls (lub 20kV Puls) Prąd implantacji : ~250 mA Doza: 1×10^{18} at /cm² Użyty gaz: Azot Liczba płytek Si $\varnothing 100$mm (4"): 3</p> <p>Ciśnienie spoczynkowe w komorze: 5×10^{-6} mbar (po 7 godzinach pompowania)</p> <p>2/ Końcowy test akceptacyjny w siedzibie zamawiającego obejmujący:</p> <p>Test 1 : Napięcie przyspieszające: 100 V DC Prąd implantacji: ~1 mA Doza : 1×10^{14} at /cm² Użyty gaz: BF₃ Liczba płytek Si $\varnothing 100$mm lub $\varnothing 150$ mm (4" lub 6"), typu-n: 3</p> <p>Test 2 : Napięcie przyspieszające : 1kV Puls Prąd implantacji : ~ 100 mA Doza : 1×10^{16} at /cm² Użyty gaz: BF₃ Liczba płytek $\varnothing 100$mm lub $\varnothing 150$ mm (4" lub 6"), typu-n: 3 Liczba płytek Si $\varnothing 100$mm lub $\varnothing 150$ mm (4" lub 6"), typu-n z maską FR: 3[*] (* z chłodzeniem za pomocą Chillera)</p> <p>Test 3 : Napięcie przyspieszające : 6 kV Puls Prąd implantacji : ~ 8 mA</p>	potwierdzić i podać

	<p>Doza : 1×10^{15} at /cm² Użyty gaz: BF₃ Liczba płytek Si Ø150 mm (6"), typu-n z tlenkiem powierzchniowym 10 Å: 5 Test 4 : Napięcie przyspieszające: 20 kV Puls Prąd implantacji : ~ 1 mA Doza : 1×10^{14} at /cm² Użyty gaz: BF₃ Liczba płytek Si Ø150 mm (6"), typu-n: 3 Test 5 : Napięcie przyspieszające : 20 kV Puls Prąd implantacji : ~ 1 mA Doza : 1×10^{14} at /cm² Użyty gaz: PH₃ Liczba płytek Si Ø150 mm (6"), typu-p: 3 Test 6 : Napięcie przyspieszające : 20 kV Puls Prąd implantacji : ~ 300 mA Doza : 1×10^{17} at /cm² Użyty gaz: BF₃ Liczba płytek Si Ø100mm lub Ø150 mm (4" lub 6"), typu-n: 3 Liczba płytek Si Ø100mm lub Ø150 mm (4" lub 6"), typu-n z maską FR : 3^{*/} (*z chłodzeniem za pomocą Chillera) Test 7 : Napięcie przyspieszające : 20 kV Puls Prąd implantacji : ~ 240 mA Doza: 1×10^{17} at/cm² Użyty gaz: PH₃ Liczba płytek Si Ø100mm lub Ø150 mm (4" lub 6"), typu-p: 3 Liczba płytek Si Ø100mm lub Ø150 mm (4" lub 6"), typu-p z maską FR : 3^{*/} (*z chłodzeniem za pomocą Chillera) Test 8 : Niejednorodność implantacji: ≤ 3%, (wzór: $100\% \times \sigma / \text{średnia ar. } R_s$ gdzie: σ = odchylenie standardowe) Skalkulowana (z użyciem wzoru) dla każdej z 5 zaimplantowanych płytek Si Ø 150 mm według Testu 3 wraz z cyklem wygrzewania (1000°C, N₂, 30 min), z wykorzystaniem wyników pomiarów rezystancji powierzchniowej R_s [Ω/kw.] w 9 punktach na płytce zgodnie z SEMI STD. Test 9 : Niejednorodność implantacji między płytkami: ≤ 3%, (wzór: $100\% \times \sigma / \text{średnia ar. } R_{s-1-5pt. Si}$ gdzie: σ = odchylenie standardowe) Skalkulowana (z użyciem wzoru) dla płytek Ø150 mm z Testu 8 o numerach od 1 do 5 z wykorzystaniem płytkowych średnich wyników pomiarów R_s Test 10 : Testy zanieczyszczeń metalicznych: ≤ 5×10^{10} at/cm² dla Fe ≤ 5×10^{11} at/cm² dla Al Stosując następujące parametry implantacji: BF₃, 10kV, 5×10^{16} at/cm², - płytki Si Ø100mm lub Ø150 mm (4" lub 6") Metoda testowania: TXRF lub VPD ICPMS z płytką odniesienia</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		Test 11 : Ciśnienie spoczynkowe w komorze : $\leq 5 \times 10^{-6}$ mbar (po 7 godzinach pompowania)	
18.	Szkolenie	1/ Wstępne szkolenie dla 3 osób w zakresie wykonywania procesów implantacji oraz czynności serwisowych podczas wstępnego testu akceptacyjnego 2/ Zasadnicze szkolenie dla 4 osób podczas testu akceptacyjnego w siedzibie zamawiającego obejmujące: Obsługę urządzenia interfejs użytkownika, tworzenie przepisu procesu implantacji, ustawianie parametrów plazmy i jej optymalizacja, rejestracja danych, praca w trybie ręcznym i automatycznym. Czynności serwisowe źródło, komora procesowa, szafa z gazami, próżnia, osłony metalowe, zasilacze wysokiego napięcia, generator RF, monitor plazmy, modulator wysokiego napięcia, komunikaty ostrzegające o błędzie i blokady bezpieczeństwa	potwierdzić
19.	Termin realizacji zamówienia	Maksymalnie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy	potwierdzić
20.	Instrukcja obsługi i dokumentacja urządzenia	W języku polskim lub angielskim - instrukcja obsługi: plik pdf i dwa egzemplarze wydrukowane w tym jeden na papierze bezpyłowym - dokumentacja urządzenia: plik pdf i jeden egzemplarz wydrukowany	potwierdzić
21.	Karty katalogowe	Karty zawierające opis podstawowych parametrów technicznych oraz zdjęcia oferowanego urządzenia	załączyć
22.	Części i materiały zużywalne w okresie gwarancji	Zestaw części i materiałów zużywalnych (w tym zestaw części i materiałów do Źródła) muszą być zapewnione i dostarczone wraz z urządzeniem i uwzględnione w jego cenie	potwierdzić i załączyć wykaz
23.	Części zamienne	Zapewnione przez 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego	potwierdzić
24.	Bezpłatna pomoc techniczna i procesowa	Zapewniona przez co najmniej 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego	potwierdzić
25.	Reakcja serwisu	Zapewniona w ciągu max. 3 dni roboczych po zgłoszeniu reklamacji	potwierdzić
26.	Wsparcie techniczne i procesowe	Zapewnione przez 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego	potwierdzić
27.	Okres gwarancji	Minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego	potwierdzić i podać
28.	Serwis pogwarancyjny	Zapewniony przez 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego	potwierdzić
29.	Wymagania instalacyjne systemu	Szczegółowy rysunek systemu z docelowym rozplanowaniem zasadniczych elementów i pomocniczych, z podaniem wymiarów szerokości i długości (u podstawy), wysokości, wymaganej przestrzeni dostępu dla serwisowania i instalacji, ciężaru ogólnego wraz z podaniem wymagań konstrukcyjnych i klimatycznych miejsca instalacji.	załączyć
30.	Wymagania dotyczące mediów zasilających	Wymagania instalacyjne na media zasilające: -zasilanie i moc elektryczną, sprężone suche powietrze, zasilanie azotem, woda chłodząca, odciąg gazowy termiczny i pompy, gazowy i inne	załączyć

* Zaleca się aby Wykonawca precyzyjnie i czytelnie wypełnił kolumnę nr 4 tabeli.

.....
podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

.....
pieczęć adresowa wykonawcy

.....
data

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

.....
podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

.....
pieczęć adresowa wykonawcy

.....
data

**O Ś W I A D C Z E N I E
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z przedmiotowego postępowania.

.....
podpis osoby/ osób uprawnionej/ uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

.....
pieczęć adresowa wykonawcy

.....
data

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **plazmowego implantatora jonów PIII**, oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy dostawę:

Lp.	Przedmiot dostawy	Wartość dostawy	Data wykonania dostawy	Odbiorca dostawy
1	2	3	4	5
1.				

Uwaga! Do przedstawionej w tabeli wykonanej dostawy należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie.

.....
podpis osoby /osób uprawnionej /uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

.....
pieczęć adresowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

dla Instytutu Technologii Elektronowej

Przedmiot zamówienia		Dostawa plazmowego implantatora jonów PIII.
1.	Nazwa i adres Wykonawcy	
2.	NIP	
3.	Telefon: Fax: e-mail:	
4.	Cena oferty netto PLN* / EUR* / USD* / GBP* słownie:.....
	Stawka podatku VAT%
	Wartość VAT
	Cena oferty brutto PLN* / EUR* / USD* / GBP* słownie:
5.	Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy	Podać :
6.	Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy	
7.	Części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom	
8.	Dokumenty załączone do oferty	1. . .
9.	Miejscowość Data sporządzenia oferty	

.....
podpis osoby /osób uprawnionej /uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy